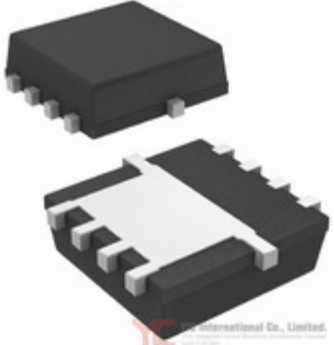

	<h2 style="color: red;">SI7100DN-T1-E3</h2>
	Hersteller-Teilenummer: SI7100DN-T1-E3
	Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 8V 35A 1212-8
	Datenblätter:  SI7100DN-T1-E3.pdf
	RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, 5121 pcs Stock Available.
	Liefern von: Hong Kong
	Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	


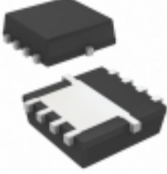

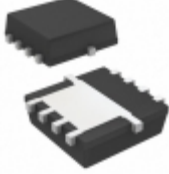
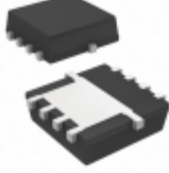


Spezifikationen

Teilenummer	SI7100DN-T1-E3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 8V 35A 1212-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	5121 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Vgs (Max)	±8V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3.5 mOhm @ 15A, 4.5V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 52W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® 1212-8
Andere Namen	SI7100DN-T1-E3TR
Betriebstemperatur	-50°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3810pF @ 4V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	105nC @ 8V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	2.5V, 4.5V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 8V 35A (Tc) 3.8W (Ta), 52W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	35A (Tc)

SI7100DN-T1-E3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SI7100DN-T1-E3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SI7100DN-T1-E3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SI7100DN-T1-E3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SI7060-B-03-IV Energy Micro (Silicon Labs) +/- 1C ACCURACY I2C TEMP SENSORS</p>	 <p>SI7101DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET P-CH 30V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p>SI7060-B-02-IVR Energy Micro (Silicon Labs) +/- 1C ACCURACY I2C TEMP SENSORS</p>	 <p>SI7100DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 8V 35A PPAK 1212-8</p>
 <p>SI7100DN-T1-E3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 8V 35A 1212-8</p>	 <p>SI7101DN-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 30V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p>SI7100DN-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 8V 35A PPAK 1212-8</p>	 <p>SI7100DN SI SI7100DN SI</p>

SI7100DN-T1-E3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SI7100DN-T1-E3 Datenblatt	SI7100DN-T1-E3-Datenblätter	SI7100DN-T1-E3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SI7100DN-T1-E3
SI7100DN-T1-E3 Electronic	SI7100DN-T1-E3-Komponenten	SI7100DN-T1-E3-Verteiler	SI7100DN-T1-E3-Bild	SI7100DN-T1-E3 Aktie	SI7100DN-T1-E3 Inventar
SI7100DN-T1-E3 Preis	SI7100DN-T1-E3 Hersteller	SI7100DN-T1-E3 garantiert	SI7100DN-T1-E3 Bild	SI7100DN-T1-E3 RFQ	SI7100DN-T1-E3 Online bestellen
SI7100DN-T1-E3 Neu	SI7100DN-T1-E3 Original				

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited